

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成20年7月17日 (2008.7.17)

【公開番号】特開2006-49847(P2006-49847A)

【公開日】平成18年2月16日 (2006.2.16)

【年通号数】公開・登録公報2006-007

【出願番号】特願2005-186509(P2005-186509)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/10 (2006.01)

H 0 1 L 21/288 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 K 3/04 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 51/05 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/10 C

H 0 1 L 21/288 Z

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 K 3/04

H 0 1 L 29/78 6 1 7 J

H 0 1 L 29/78 6 2 7 C

H 0 1 L 21/88 B

H 0 1 L 29/28

【手続補正書】

【提出日】平成20年6月4日 (2008.6.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】配線基板の作製方法及び薄膜トランジスタの作製方法

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被処理物を形成し、

前記被処理物の表面の一部を改質して、第 1 の領域と、前記第 1 の領域と境界線を有する第 2 の領域とを形成し、

前記境界線を越えて、前記第 1 の領域の一部及び前記第 2 の領域に連続的に導電性材料を含む組成物を吐出し、

前記組成物を固化して導電層を形成し、

前記導電層に接着面を有する物質の前記接着面を接着し、
前記接着面を有する物質、及び前記境界線を越えて前記第１の領域の一部に形成された導電層を剥離することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項２】

被処理物を形成し、
前記被処理物の表面の一部を光の照射により改質して、第１の領域と、前記第１の領域と境界線を有する第２の領域とを形成し、
前記境界線を越えて、前記第１の領域の一部及び前記第２の領域に連続的に導電性材料を含む組成物を吐出し、
前記組成物を固化して導電層を形成し、
前記導電層に接着面を有する物質の前記接着面を接着し、
前記接着面を有する物質、及び前記境界線を越えて前記第１の領域の一部に形成された導電層を剥離することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項３】

請求項１または２において、前記被処理物の表面の一部を改質することによって、前記第２の領域は前記第１の領域より前記導電層に対する密着性が高くなることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項４】

請求項１乃至３のいずれか一項において、前記光はレーザ光を用いることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項５】

請求項１乃至４のいずれか一項において、前記被処理物はフッ素炭素鎖を有する材料であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項６】

被処理物を形成し、
前記被処理物の表面の一部を改質して、第１の領域と、前記第１の領域と境界線を有する第２の領域とを形成し、
前記境界線を越えて、前記第１の領域の一部及び前記第２の領域に連続的に導電性材料を含む組成物を吐出し、
前記組成物を固化してゲート電極層を形成し、
前記導電層に接着面を有する物質の前記接着面を接着し、
前記接着面を有する物質、及び前記境界線を越えて前記第１の領域の一部に形成されたゲート電極層を剥離することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項７】

被処理物を形成し、
前記被処理物の表面の一部を光の照射により改質して、第１の領域と、前記第１の領域と境界線を有する第２の領域とを形成し、
前記境界線を越えて、前記第１の領域の一部及び前記第２の領域に連続的に導電性材料を含む組成物を吐出し、
前記組成物を固化してゲート電極層を形成し、
前記導電層に接着面を有する物質の前記接着面を接着し、
前記接着面を有する物質、及び前記境界線を越えて前記第１の領域の一部に形成されたゲート電極層を剥離することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項８】

請求項６または７において、前記被処理物の表面の一部を改質することによって、前記第２の領域は前記第１の領域より前記ゲート電極層に対する密着性が高くなることを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項９】

請求項６乃至８のいずれか一項において、前記光はレーザ光を用いることを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 10】

請求項 6 乃至 9 のいずれか一項において、前記被処理物はフッ素炭素鎖を有する材料であることを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。